



TYPES NOW OBSOLETE :

424 PF E 1 - 424 PF S 1 - 434 T S 1 - RPS 5 - RPS 5 PF - 1384 S 1 -
CHS 70 A NE 11 P - CHS 74 GS 21 PF - CHS 70 B GE 11 P -

TYPES TO KEEP :

Photoconductive cell : RPX 10 ✓ *done*
Photocoupler : CHS 70 GE 11 PF ✓

NEW TYPES :

16. SENSOR: PHOTOCONDUCTIVE CELL (LDR)

10. SENSOR PHOTOCONDUCTIVE CELL (LDR)															(1) MAX. PWR. DISS. Pcase (2) PK WAVELENGTH (3) MAX. VOLT & (4) TYPE No.									
LINE No.	TYPE No.	1 MAX. PWR @ 25°C Pcase (W)	2 PEAK WAVELENGTH λ_p (nm)	3 MAX. VOLT V (V)	TEMP. RING. CODE	LIGHT RESISTANCE				S O U R C E	DARK RESISTANCE						S O U R C E	MATERIAL & FEATURES	LEAD CODE	DRAWING CODE				
						R _{on} (Ω)	E _v		E _a (W/cm ²)		R _{off} (Ω)	SECS. AFTER (S)	E _v		E _a (W/cm ²)									
							(f _c)	(l _x)					(f _c)	(l _x)										
-	112 M 3	200m	600n	120	47	3000			50	C	10M	5			100	C	BA							
-	PCV67VS1	50m	580n	200	5C	20K			10	C	1M	5			10	C	BA							
-	PCV104VS5	100m	580n	300	5C	4K			10	C	5M	5			10	C	BA							
-	PCV104VE1D	100m	730n	120	5C	3K			10	C	10M	1			10	C	BB	DUAL						

46. MISCELLANEOUS DEVICES

40. MISCELLANEOUS DEVICES												
LINE No.	TYPE No.	USE	PARAMETERS					TEMP RING. CODE	DESCRIPTION	SCHEMATIC	DRAWING Ø-RND. □-RECT. Δ-STRIP *CHIP	
			ELECTRICAL			OPTICAL						
			MAX DISS. (W)	VOLT (V)	CURR. (A)	PK W/L λp (m)	INTENS. Iv (cd)					
- CDA S		6	30	60		600-800n		47	Res. 3-10KΩ - Linearity ±2% (±0,1% if required)			
- CDR7...150		6	30	60		600-800n		47	Res. 500Ω - 100 KΩ - Linearity ±2%			

25. PHOTOCOUPLER: PHOTOCELL (LDR, VOLTAIC) OUTPUT

25. PHOTOCOUPLER: PHOTOCELL (LDR,VOLTAIC) OUTPUT													IN ORDER OF: (1)TYPE OF PHOTOCELL (2)ISOLATION VOLT. VIO & (3) TYPE No.					
LINE No.	TYPE No.	TYPE OF PHOTO CELL	MAX. PWR. DISS. CASE (W)	TEMP. RING. CODE	COUPLED CHAR.			INPUT SOURCE		OUTPUT PHOTOCELL				RATED INPUT		MATER. & FEATURE MAT	SCHEM -ATIC	DRAWING Ø-RND. Ø-RECT. Δ-STRIP *-CHIP
					2 I/O ISOL VOLT (V)	RISE TIME (S)	DECAY TIME (S)	TYPE	VOLT Δ-V _R (V)	CURR. Δ-I _R (A)	DC CELL VOLT *AC ΔP _k (V)	SHORT CKT.I I _{sc} (A)	OPEN CKT.V V _{oc} (V)	ON RESIS. R _{on} (Ω)	OFF RESIS. R _{off} (Ω)			
-	CHS70BGE1CD	LDR	50	47	100K	3	20	LED	1,8	10m	60			1K	100M	BB		
-	PCNS21P	LDR	120	47	2,5K	40	80	GAS	100	0,3m	400			2K	10M	BA		
-	CS81GE11PF	LDR	120	47	2,5K	3	20	LED	1,8	10m	60			100	10M	BB		
-	CS81GE12PF	LDR	120	47	2,5K	3	20	LED	1,8	10m	60			400	10	BB DUAL		
-	CS85GE12D	LDR	50	47	2,5K	3	20	LED	1,8	10m	30			400	1	BB DUAL		

Tous les modèles SEGOR sont réalisés dans 4 matériaux principaux : le CDS H 35 (S1), le CDS H 50 (S2), le CDSE H 35 (E1), le CDSE X 5 (E3), dont les caractéristiques particulières fixent les domaines d'application. Par exemple, le S1 et le E1 sont très sensibles aux faibles éclaircissements :

le premier est plus stable dans le temps mais de réponse plus lente et il est utilisé en photométrie, dans les commandes automatiques d'éclairage (éclairage public, balises, affichages à cristaux liquides...), détection de fumées, etc...

le deuxième a un fort coefficient de température mais il est de réponse rapide et est utilisé en tout ou rien dans les organes électroniques, les photocoupleurs à puissance de commande très faible < 3 mw... etc...

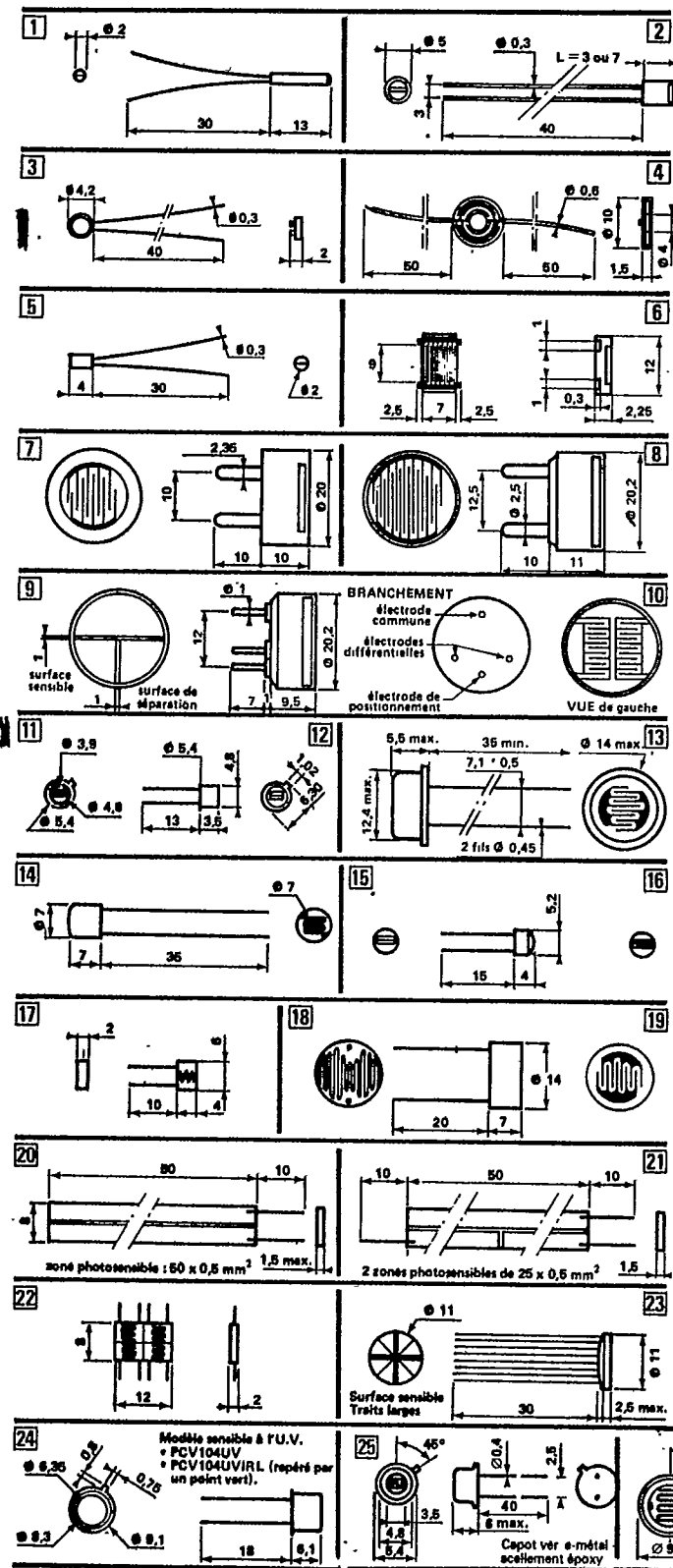
NOTA : D'autres matériaux ont dû être mis en œuvre pour mieux répondre aux problèmes posés : le CDS H 35 1G (S4), le CDS H 55 (S5), etc...

MODÈLES STANDARD STANDARD TYPES

OE-16 1100
TOUS LES MODÈLES
SONT FABRIQUÉS
DANS TOUS LES MATÉRIAUX

EXEMPLES TYPES

BOITIER	Matériaux	P max. 25 °C mW	U max. V	R typ. à 100 Lux KΩ	R min. obscurité en 5 sec. MΩ	Fig.
111	S2	40	180	60	10	1
422	S1	50	600	20	10	2
424 PF	E1	50	30	0,7	1	3
1044	S2	120	120	8	10	4
1114	E1	20	45	15	10	5
1160PF	S1	120	120	0,4	0,05	6
1422	S2	200	600	4	10	7
1821	S2	300	600	2	10	8
1831*	E1	30	150	6	10	9
1831PN*	S1	150	600	8	10	10
PCV67V	S1	50	100	3	1	11
PCV71V	E1	30	100	5	10	12
PCV70	S2	200	120	2	10	13
PVC104	S4	100	800	10	10	14
RPX10	S1	30	400	20	10	15
RPX11	S1	40	200	4	2	16
RPX12	E1	30	30	1	1	16
RPS5C	S5	60	400	2	1	17
112M3	S2	200	120	2	10	18
112	S1	200	400	4	1	19
5090S	S1	600	800	2	0,1	20
5090D*	E1	300	150	1	1	21
RPS5C4**	S1	60	400	2	1	22
1181*	S1	50	400	20	1	23
PCV67	S1	75	800	8	1	25
PCV104V	S1	100	300	2	0,5	26
PCV104VD*	S1	100	300	4,5	0,5	27
PCV104VD*	E1	100	120	2	10	27

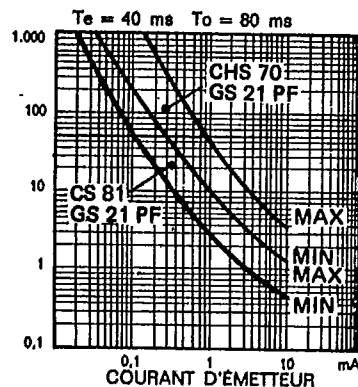


COURBES DE TRANSFERT

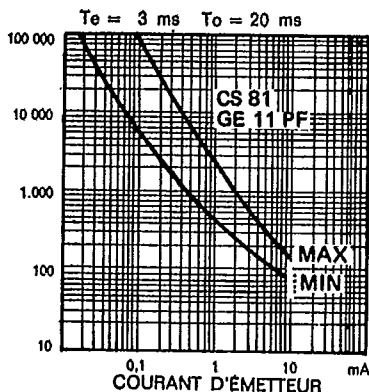
$R = F(I \text{ ou } V)$

**PHOTOCELL RESISTANCE
VERSUS VOLTAGE OR CURRENT**

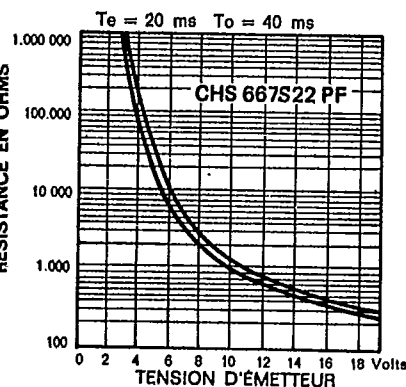
RESISTANCE EN KΩ



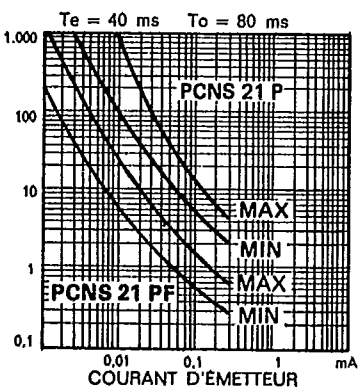
RESISTANCE EN OHMS



RESISTANCE EN OHMS



RESISTANCE EN OHMS



CODES DE MARQUAGE

- Point de couleur qui repère le pôle négatif si l'émetteur est une LED :
 - marron : matériau E1 (2 pts PF)
 - rouge : matériau E3 (2 pts PF)
 - bleu : matériau S1 (2 pts PF)
 - vert : matériau S2 (2 pts PF)

● Lettres

- G : LED

● Électrodes

- N : Néon
- PF : Basse résistance
- P : Bonne tenue en tension et bonne distorsion
- S : Fonctionnement sur secteur 220V.

● Chiffres : Lampes

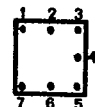
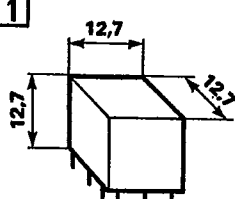
- 3 : 3volts 12mA
- 5 : 12volts 40mA
- 8 : 10volts 27mA
- 4 : 5volts 60mA
- 7 : 28volts 24mA
- 9 : 14volts 30mA

LIBELLÉ DE COMMANDE

Boîtier + Émetteur + Matériau + Nombre de PR + Électrodes — Exemple : CHS66 — 4 — S2 — 2 — P
CHS70 — G — E1 — 1 — PF

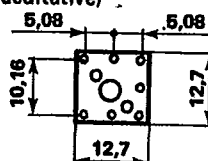
**BOÎTIERS
BOITIERS**

1



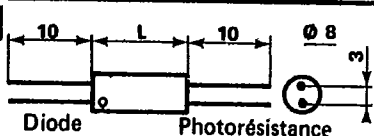
- 1-7 : 1ère photorésistance
- 2-6 : source lumineuse
- 3-5 : 2ème photorésistance (facultative)

Pôle négatif (diode électroluminescente)



Isolément : 2000 V crête

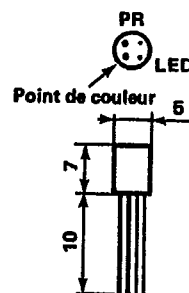
2



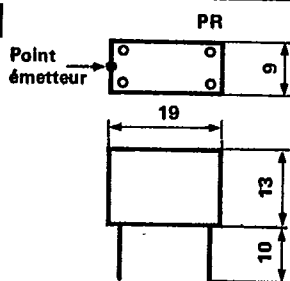
	CHS 85	CHS 70	CHS 70 A.
L (mm)	MAX. 17	25	
Isolément (V crête)	5000	10.000	

Sécurité intrinsèque : espacement ≥ 3 mm entre émetteur et récepteur, sur demande

3

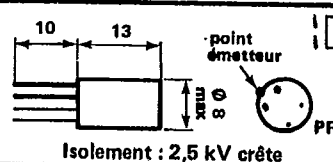


4



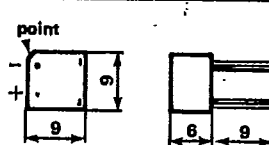
Isolément : 7,5 kV crête

5

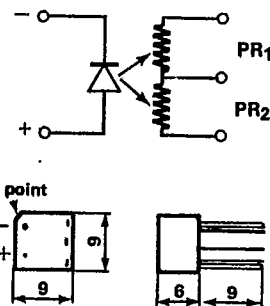


Isolément : 2,5 kV crête

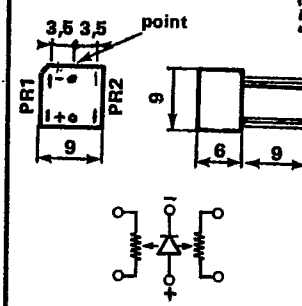
6



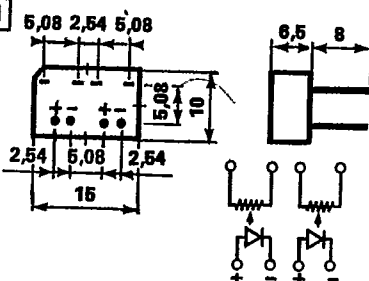
7



8



9



10

